

2013年3月期(2012年4月～2013年3月)

東京エレクトロン 決算説明会

内容:

- 2013年3月期連結決算の概要 取締役執行役員 原田 芳輝
- 2014年3月期業績予想と経営方針 代表取締役会長兼社長 東 哲郎

2013年4月30日



TOKYO ELECTRON

CORP IR/April 30, 2013



2013年3月期(2012年4月～2013年3月)

連結決算の概要

取締役執行役員 原田 芳輝

2013年4月30日



TOKYO ELECTRON

CORP IR/April 30, 2013



業績サマリー

(億円)

	2012年3月期	2013年3月期	対前年増減
売上高	6,330	4,972	-21.4%
売上総利益 下段:売上総利益率	2,114 33.4%	1,587 31.9%	-24.9%
販管費	1,510	1,462	-3.2%
営業利益 下段:営業利益率	604 9.5%	125 2.5%	-79.2%
税前利益	606	177	-70.7%
当期純利益	367	60	-83.5%
1株当たり当期純利益(円)	205.04	33.91	-83.5%
研究開発費	815	732	-10.1%
設備投資額	395	217	-44.9%
減価償却実施額	241	266	+10.1%

半導体およびFPD設備投資の低迷を受け、売上が減少。将来を見据えた企業買収による経費増があったが、コスト削減により収益性を改善。

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています

2

部門別売上高

		2012年3月期		2013年3月期		対前年増減
		売上高	構成比	売上高	構成比	
	SPE	4,778	75.5%	3,920	78.8%	-18.0%
	FPD/PVE	698	11.0%	201	4.1%	-71.2%
	EC/CN	848	13.4%	846	17.0%	-0.2%
	その他	4	0.1%	4	0.1%	-2.9%
合計		6,330		4,972		-21.4%

■ SPE (半導体製造装置)

メモリ投資の低迷により売上が減少。国内、韓国での売上が前年比半減。一方、ロジック投資は堅調を維持し、米国、台湾での売上は前年比増加。

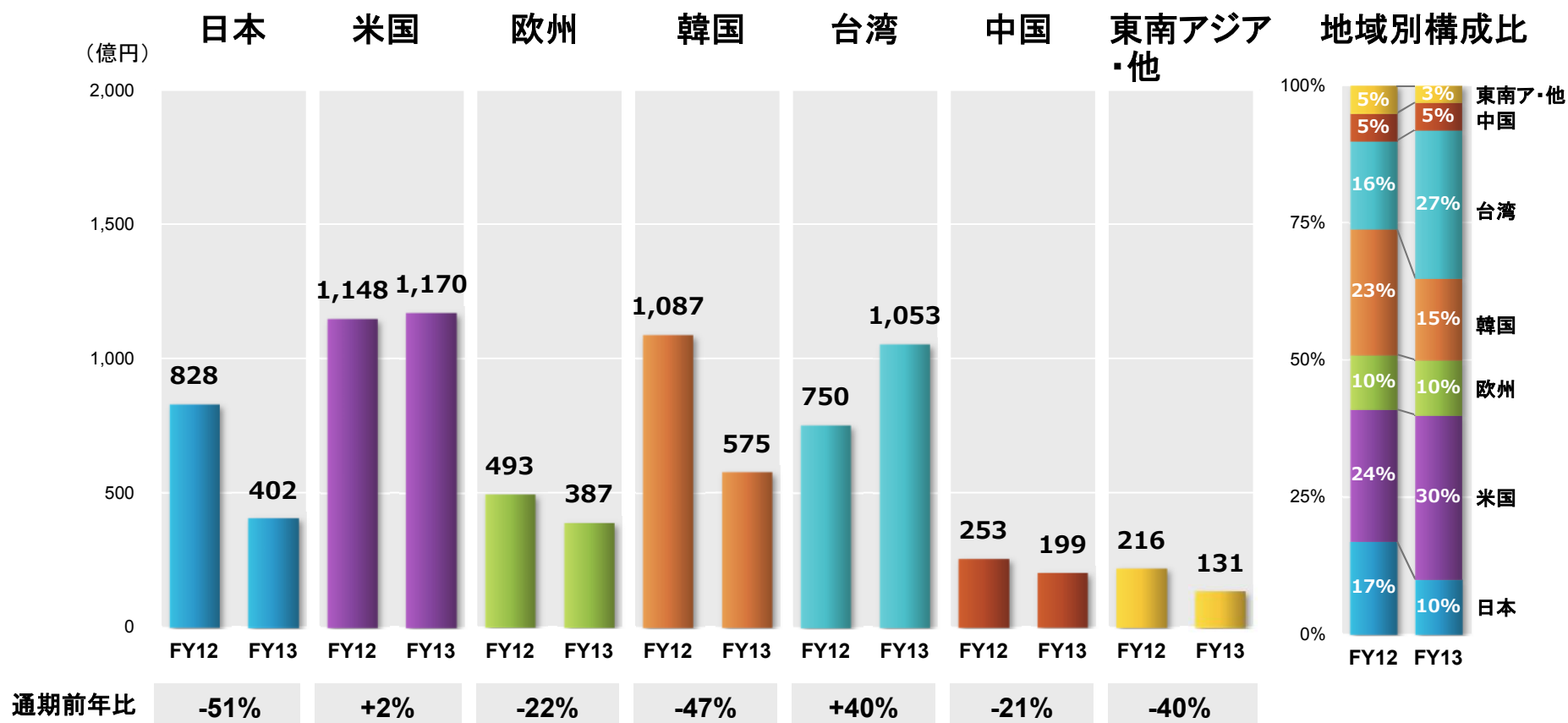
■ FPD (FPD製造装置)

大型FPD(フラットパネルディスプレイ)用設備投資が先送りされ、装置市場が大幅縮小。その影響で売上が大幅減少。

■ EC/CN (電子部品/コンピュータ・ネットワーク)

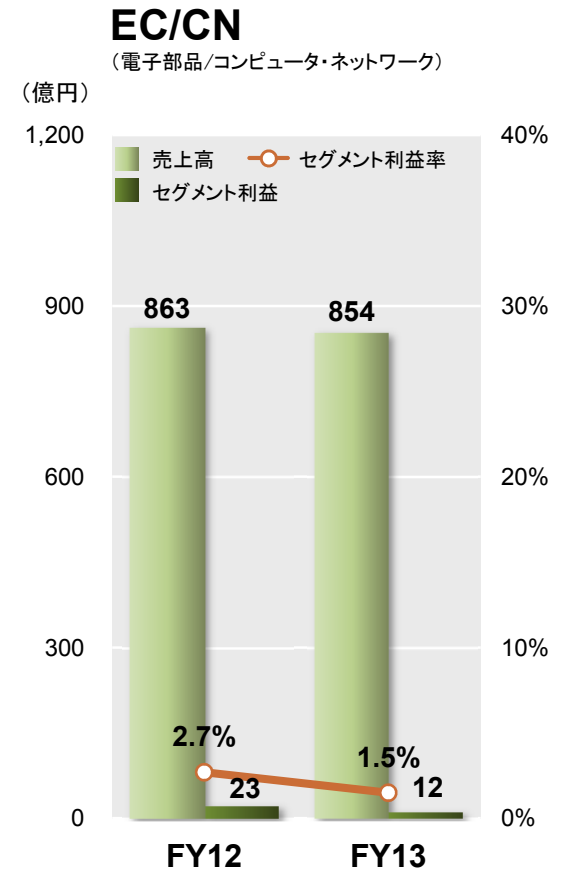
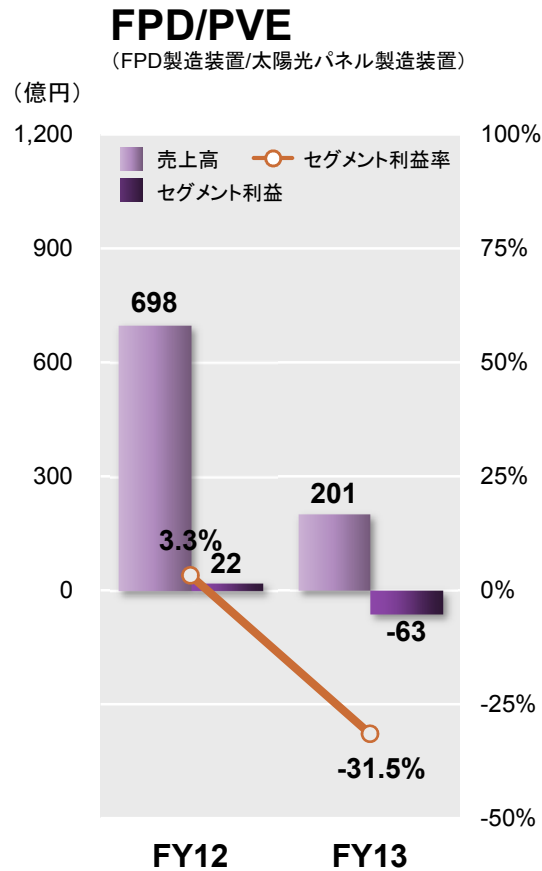
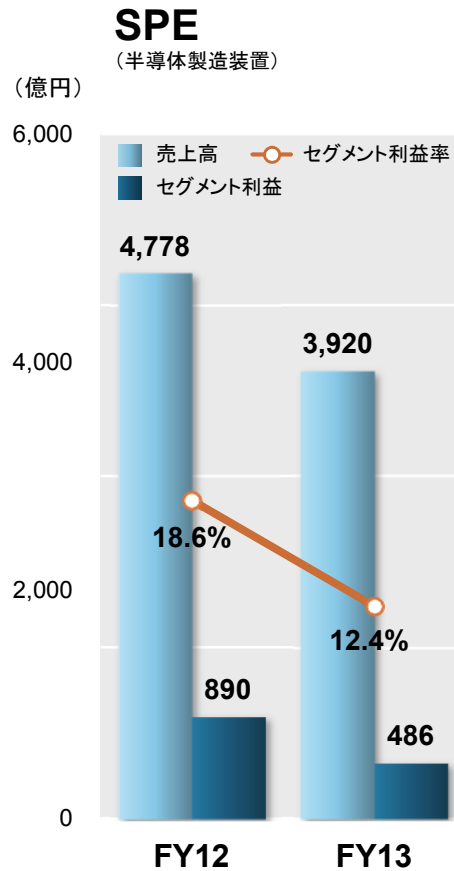
電子部品は、需要低迷により国内売上が減少したが、海外売上の伸長により、全体では微減に留まった。コンピュータ・ネットワーク機器は前年比微増。

SPE部門地域別売上高



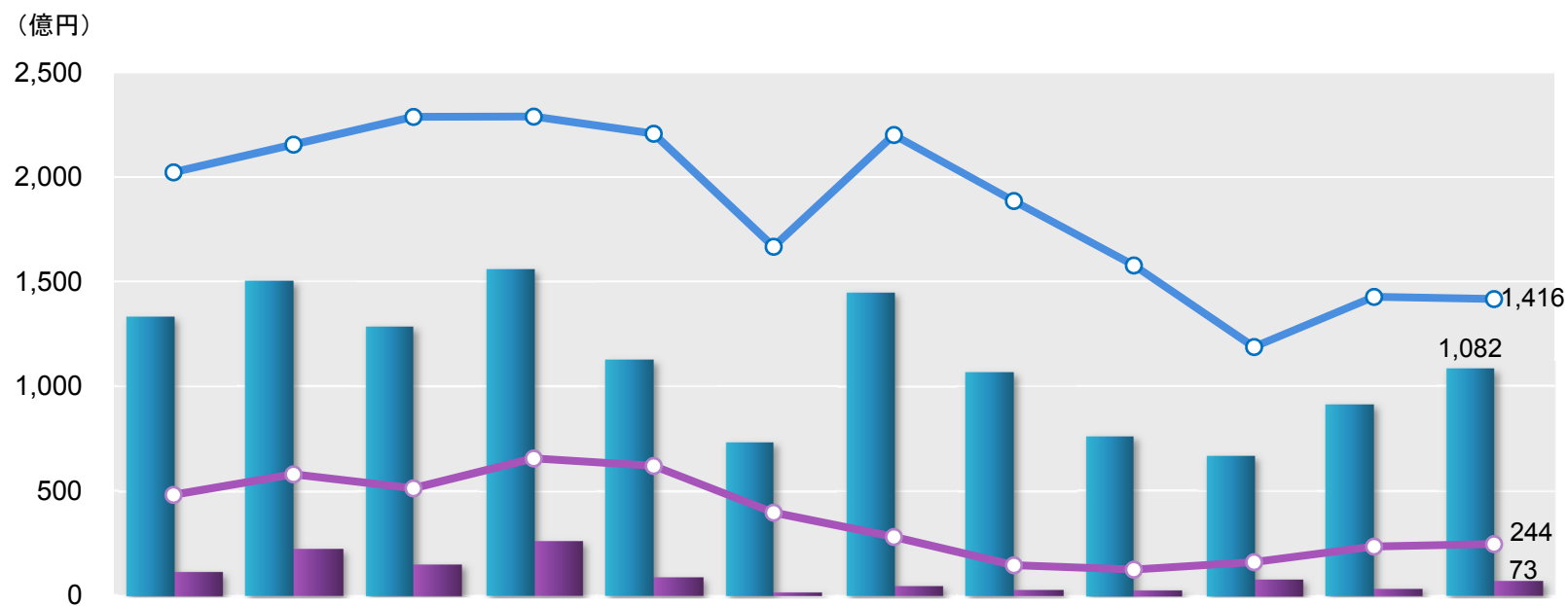
通期前年比および構成比は、1円単位の金額をもとに計算しています。

セグメント情報



1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用(主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費): FY12; 348億円 FY13; 270億円
3. 利益率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

受注額・受注残高

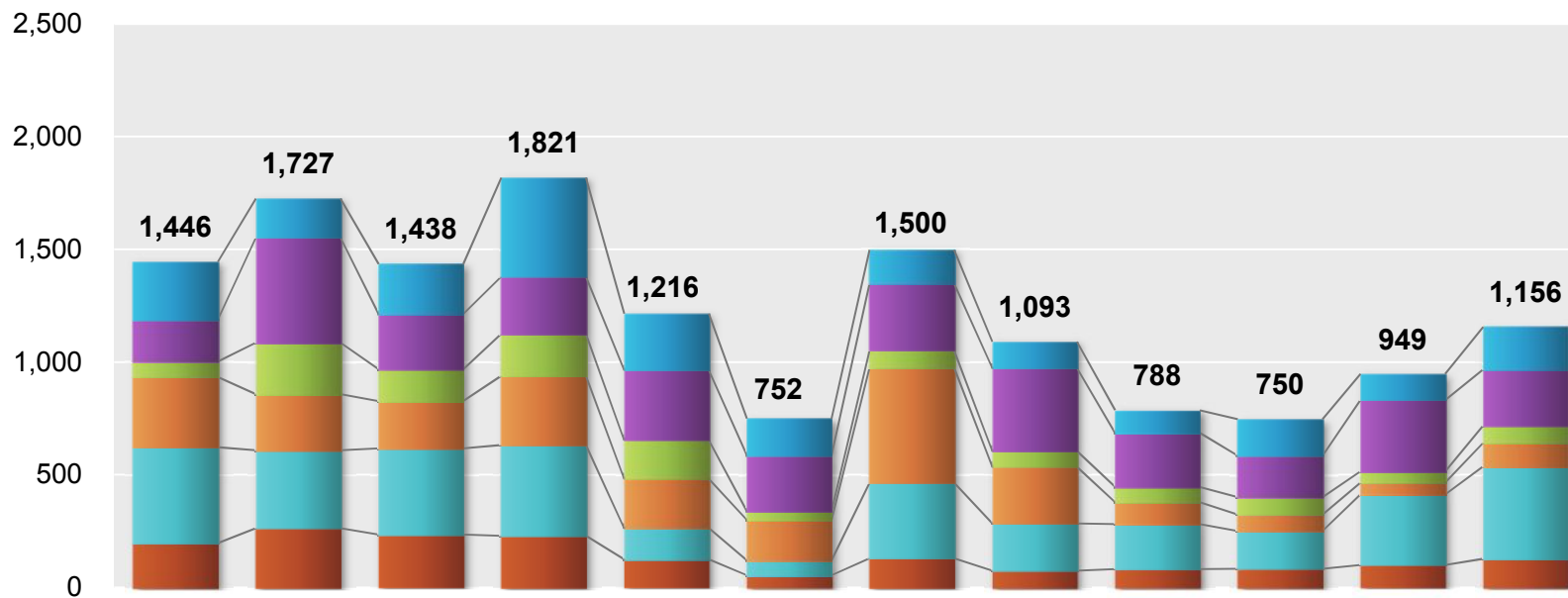


	FY11 1Q	2Q	3Q	4Q	FY12 1Q	2Q	3Q	4Q	FY13 1Q	2Q	3Q	4Q
■ 半導体製造装置 受注額	1,332	1,502	1,286	1,558	1,126	735	1,449	1,064	760	669	913	1,082
■ FPD/PV製造装置 受注額	114	224	152	263	89	17	50	28	28	80	36	73
○ 半導体製造装置 受注残高	2,023	2,155	2,288	2,289	2,207	1,667	2,201	1,886	1,577	1,187	1,426	1,416
○ FPD/PV製造装置 受注残高	479	578	510	654	618	394	278	142	122	158	232	244

FY13/3QおよびFY13/4QのFPD/PV製造装置受注残高には、PVの受注残84億円がそれぞれ含まれています。

地域別受注額：SPE, FPD/PVE

(億円)

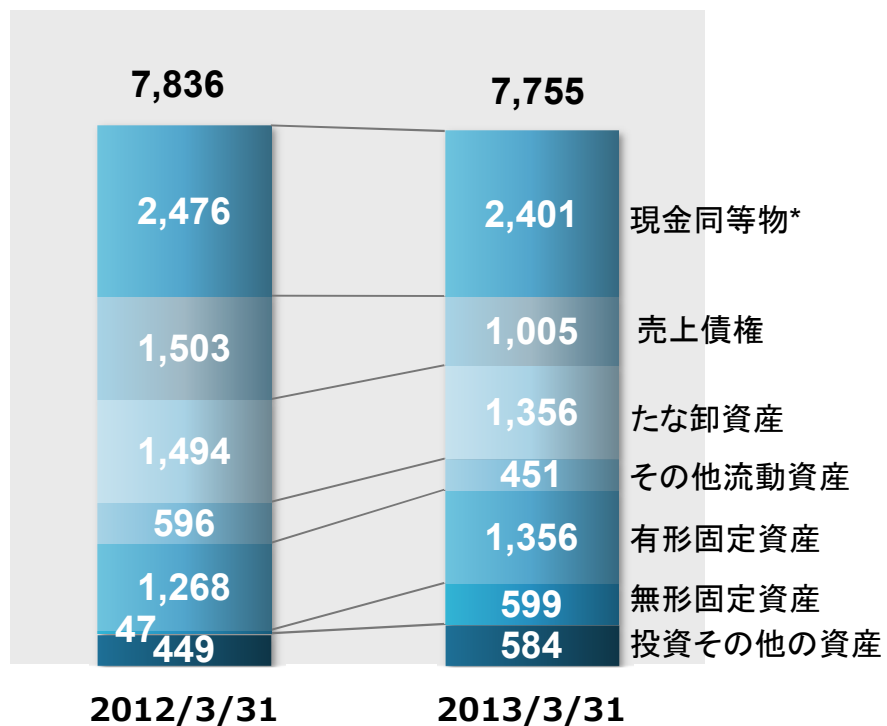


	FY11 1Q	2Q	3Q	4Q	FY12 1Q	2Q	3Q	4Q	FY13 1Q	2Q	3Q	4Q
国内	256	173	222	439	250	163	149	117	100	163	115	187
米国	186	466	245	254	311	248	297	368	240	184	317	249
欧州	69	228	141	186	172	39	76	70	68	77	50	77
韓国	311	249	210	307	219	179	511	251	97	73	52	105
台湾	425	346	382	403	137	66	335	210	200	167	313	410
中国・東南ア他	197	263	235	229	125	54	129	74	81	83	100	127

貸借対照表

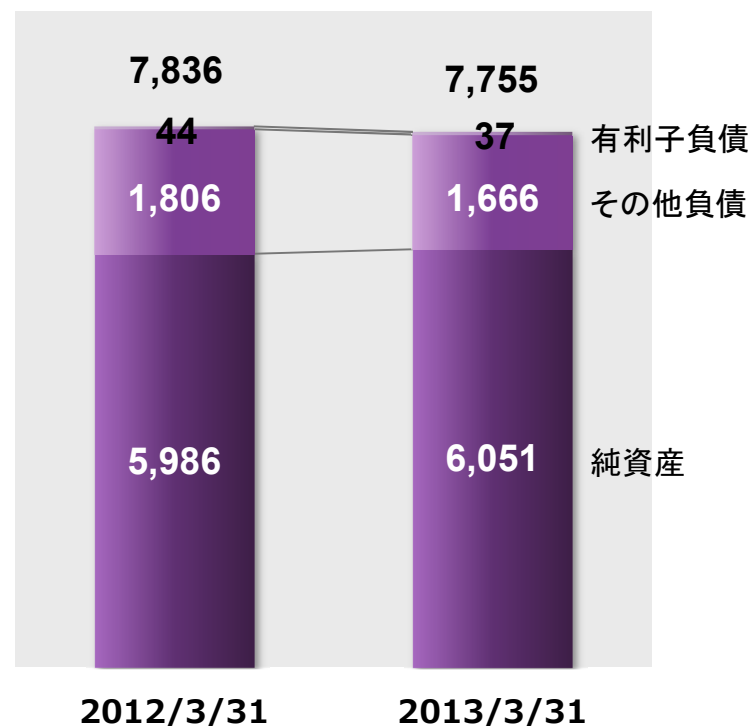
資産

(億円)



負債・純資産

(億円)

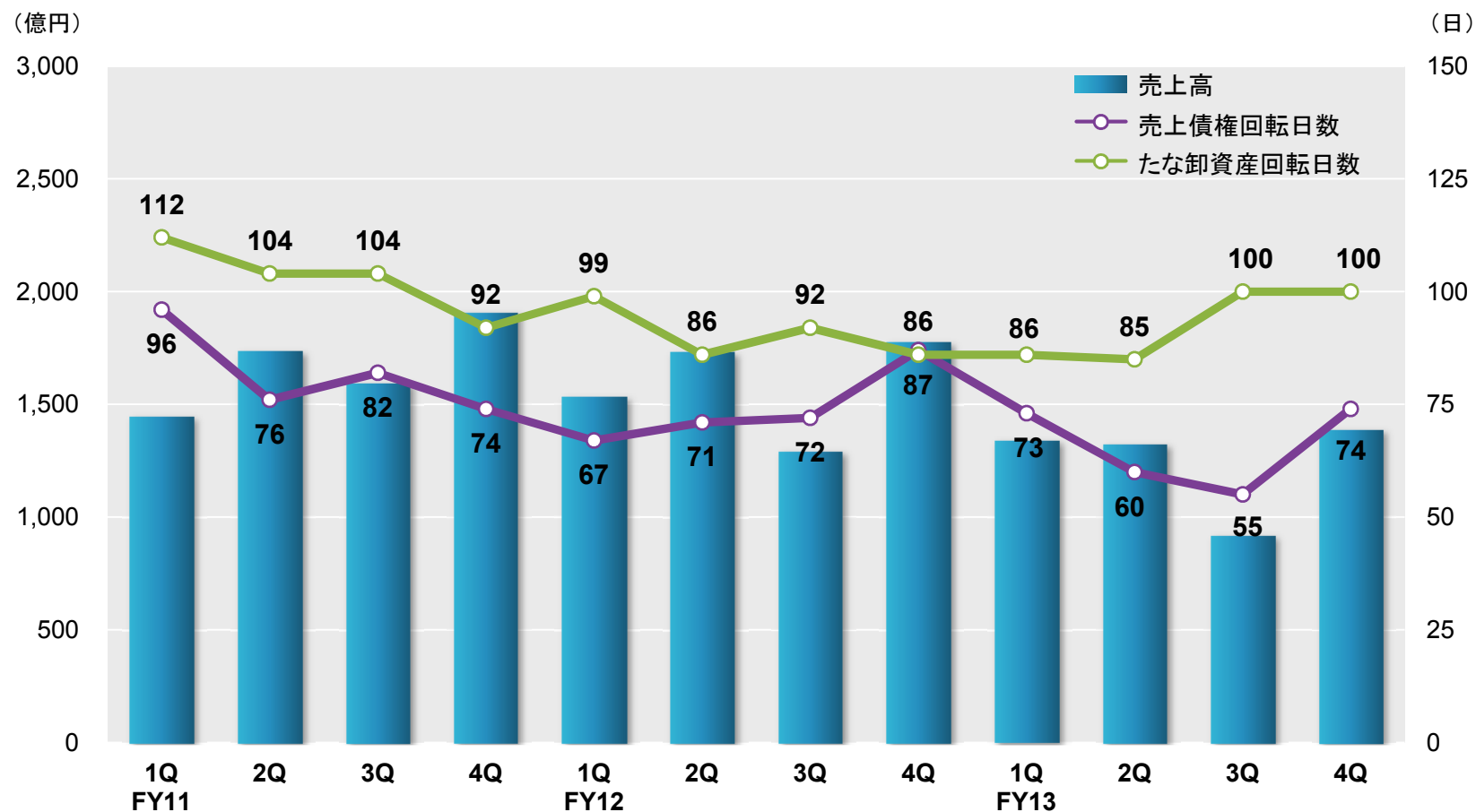


主な増減

	増減	主な要因
無形固定資産	+552	企業買収に伴うのれん等の増加 537億円

現金同等物: 現預金+短期投資等(貸借対照表上の表示は「有価証券」)

たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

	2012年3月期	2013年3月期
営業キャッシュ・フロー	297	842
税引前利益	606	177
減価償却費	241	266
売上債権の減少(△増加)	△ 155	575
たな卸資産の減少(△増加)	160	202
仕入債務の増加(△減少)	△ 58	△ 154
法人税等の支払額または還付額	△ 476	△ 76
その他	△ 21	△ 148
投資キャッシュ・フロー	△ 83	△ 1,417
設備投資	△ 360	△ 190
企業買収に伴う株式取得等による支出	△ 3	△ 561
満期3ヵ月超の預金等の増減額	310	△ 660
その他	△ 29	△ 5
財務キャッシュ・フロー	△ 273	△ 106
配当金支払い	△ 231	△ 93
その他	△ 42	△ 13
現金及び現金同等物の期末残高	1,587	853
満期3ヵ月超の定期預金・短期投資の期末残高	888	1,548
現金及び現金同等物＋満期3ヵ月超の定期預金・短期投資等の期末残高	2,476	2,401

(億円)

補足資料



TOKYO ELECTRON

CORP IR/April 30, 2013



業績サマリー

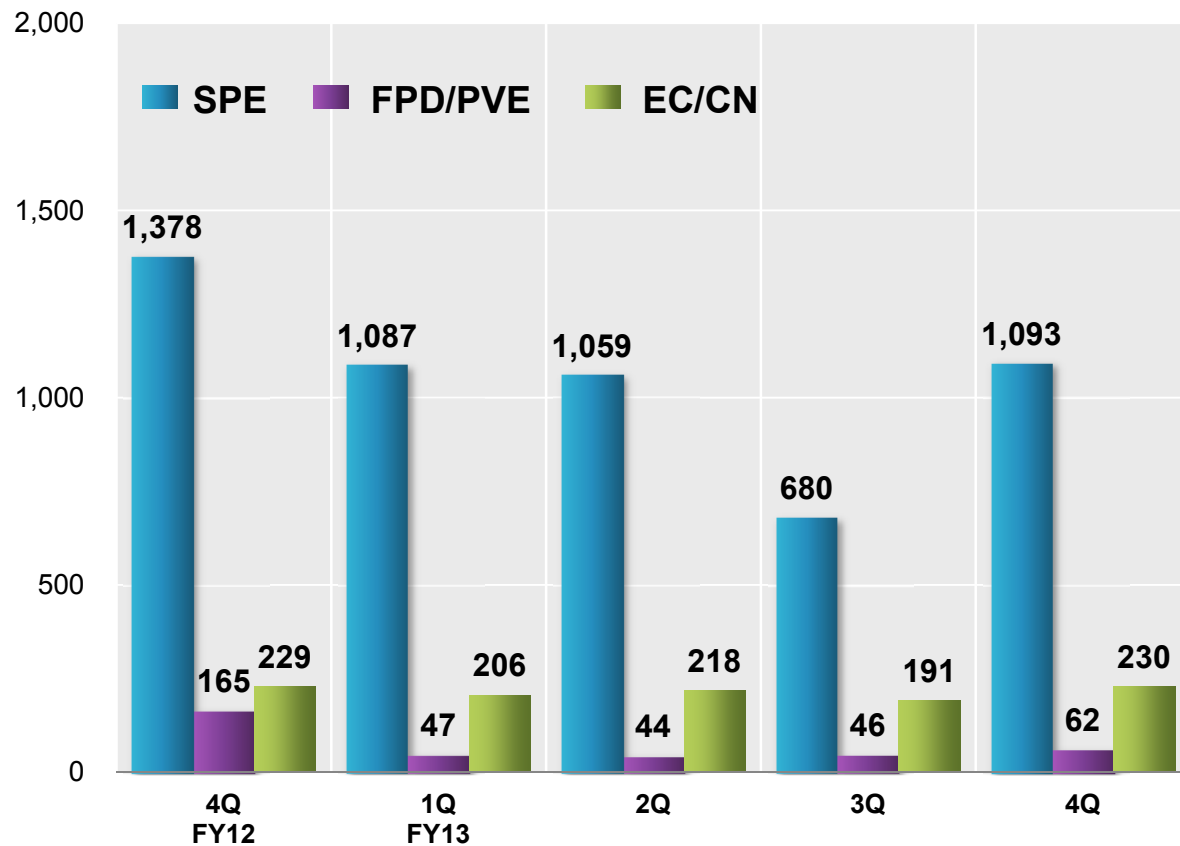
(億円)

	2012年3月期	2013年3月期					対前年4Q 増減率
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
売上高	1,775	1,341	1,324	919	1,387	-21.8%	
SPE	1,378	1,087	1,059	680	1,093	-20.7%	
FPD/PVE	165	47	44	46	62	-62.3%	
EC/CN	229	206	218	191	230	+0.6%	
その他	1	1	1	0	1	-5.6%	
売上総利益	564	441	415	282	448	-20.5%	
下段:売上総利益率	31.8%	32.9%	31.4%	30.7%	32.3%		
販管費	389	348	386	351	376	-3.4%	
営業利益	174	92	29	-68	72	-58.8%	
下段:営業利益率	9.8%	6.9%	2.2%	-7.5%	5.2%		
税前利益	146	112	43	-61	84	-42.4%	
当期純利益	93	57	3	-70	70	-24.7%	
研究開発費	216	179	194	174	183	-15.0%	
設備投資額	93	76	52	59	29	-68.2%	
減価償却実施額	71	55	62	66	82	+14.2%	

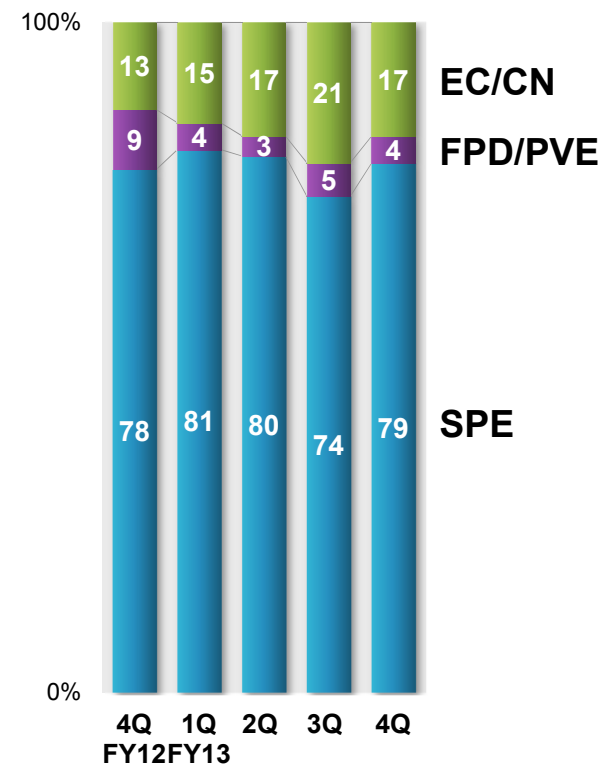
1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

部門別売上高

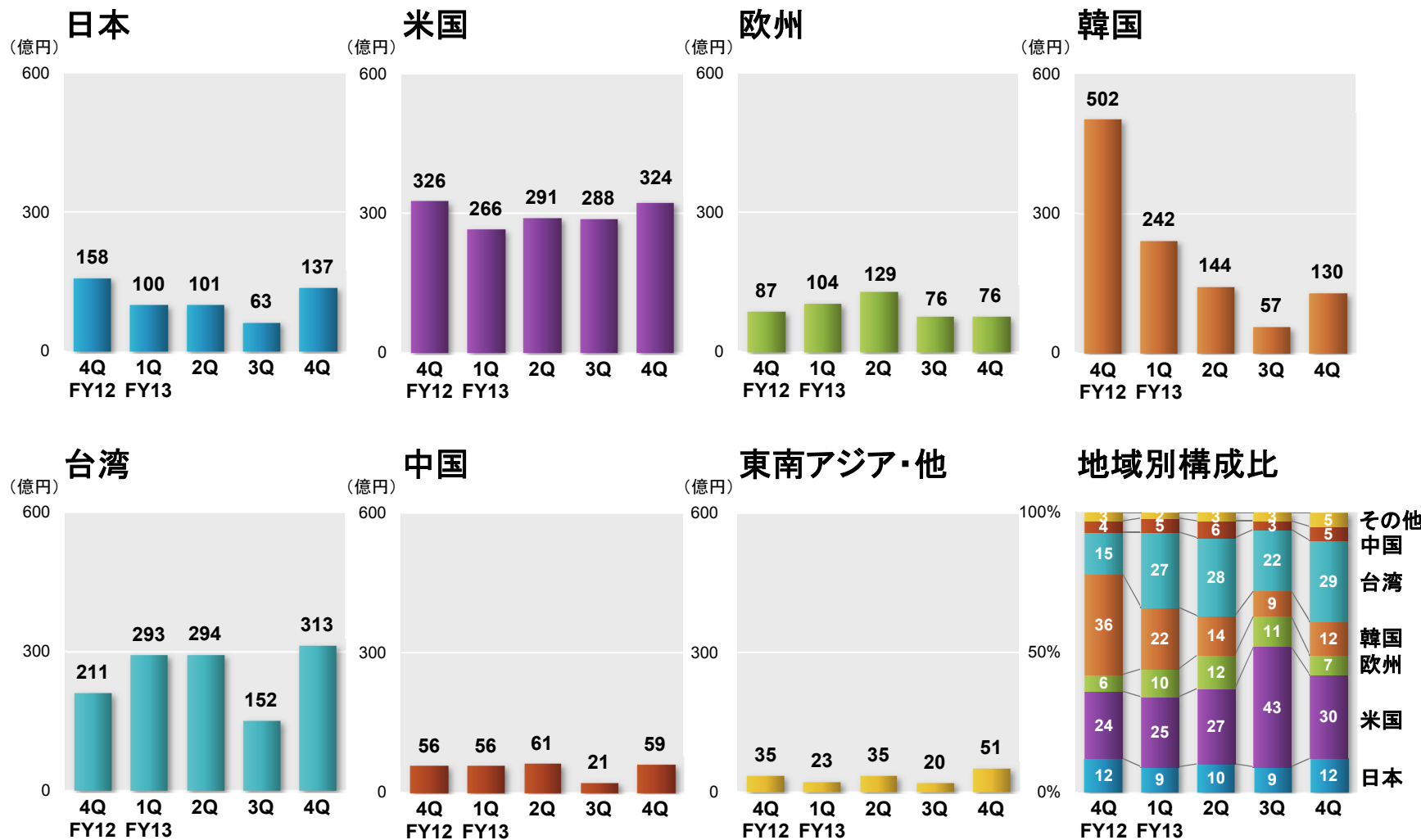
(億円)



部門別構成比



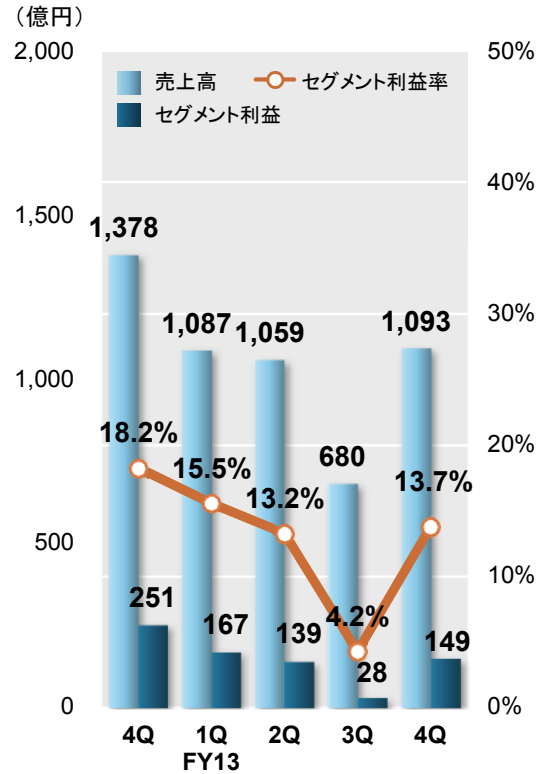
SPE部門地域別売上高



セグメント情報

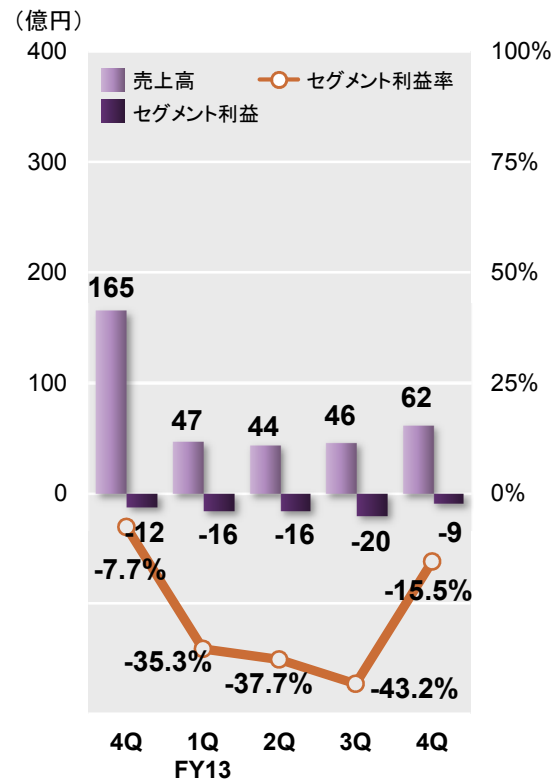
SPE

(半導体製造装置)



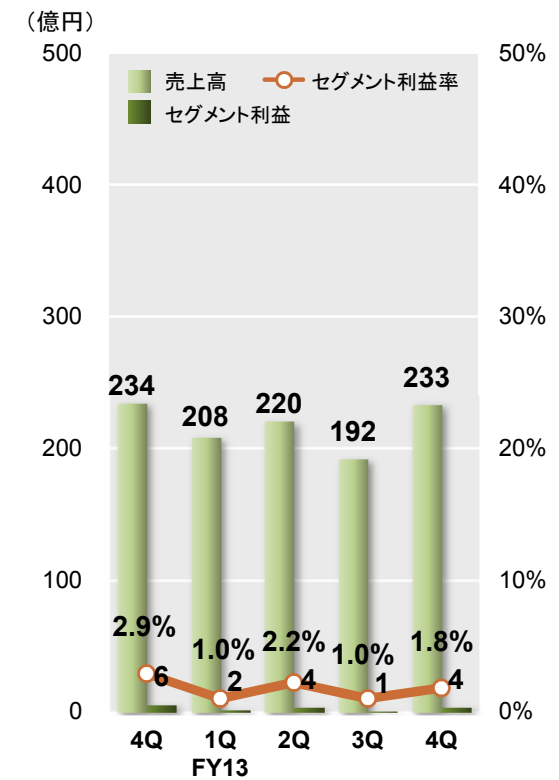
FPD/PVE

(FPD製造装置/太陽光パネル製造装置)



EC/CN

(電子部品/コンピュータ・ネットワーク)

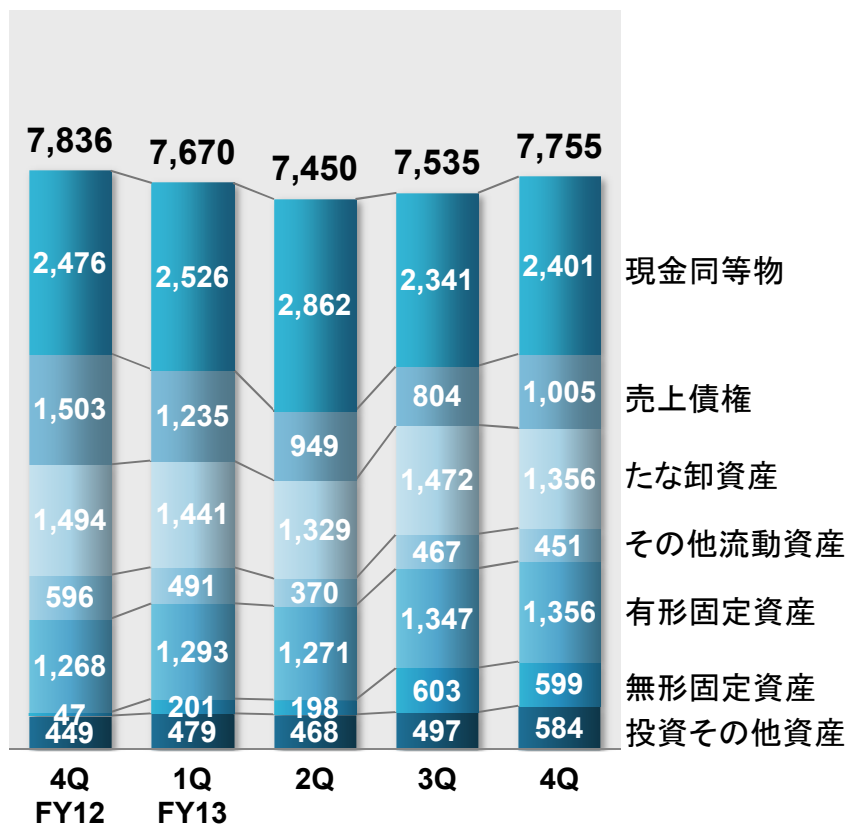


1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用(主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費)があります。
3. 利益率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

貸借対照表

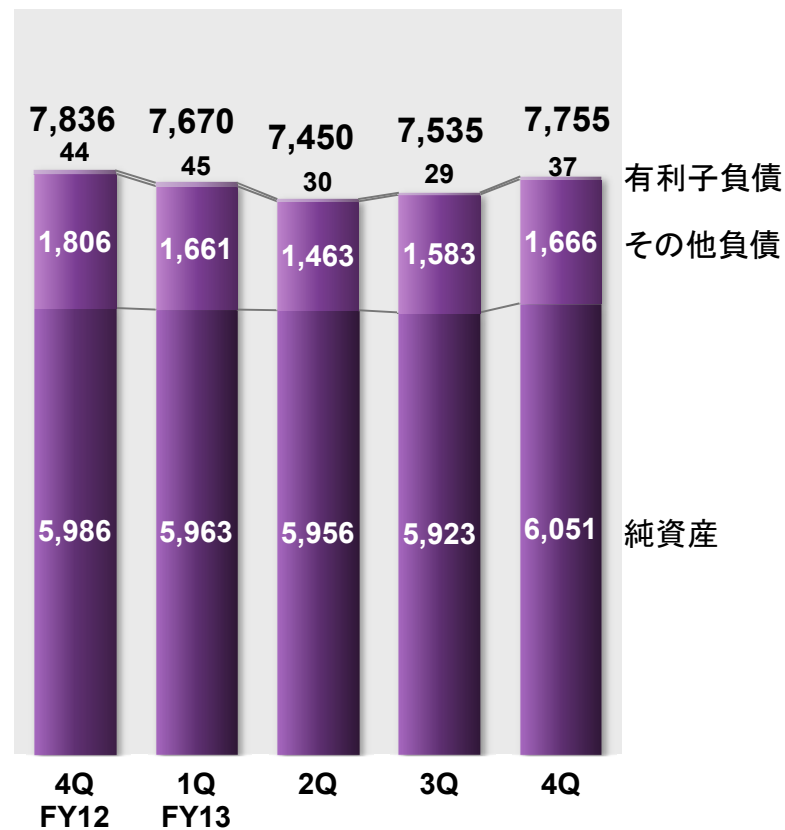
資産

(億円)



負債・純資産

(億円)



現金同等物: 現預金 + 短期投資等 (貸借対照表上の表示は「有価証券」)

従業員数

(人)

	2012年3月	2013年3月
国内	8,004	8,186
米国	1,150	1,633
欧州	313	888
アジア	1,217	1,494
合計	10,684	12,201

2014年3月期業績予想と経営方針

代表取締役会長兼社長 東 哲郎

2013年4月30日



TOKYO ELECTRON

CORP IR/April 30, 2013



2013年3月期レビュー



TOKYO ELECTRON

CORP IR/April 30, 2013



2013年3月期 事業ハイライト

▶ SPE分野におけるポジションの向上

シェア向上

コータ／デベロッパ 85%→89%、洗浄装置 16%→18%

熱処理成膜装置 58%→60%（出所: Gartner）

POR獲得

エッチング装置：RLSAによる米国ロジックメーカー複数社のPOR獲得

洗浄装置：韓国・台湾大手顧客複数社のPOR獲得

熱処理成膜装置：新製品（NT333）による複数社の開発POR獲得

▶ 固定費削減を実施 160億円

既存事業で230億円の削減

企業買収等により70億円の増加

▶ FPD中国昆山工場の稼働開始

顧客対応力向上、装置製造開始

2013年3月期 事業ハイライト

▶ 注力・成長期待分野における企業買収の実施

◆ NEXX Systems (現 TEL NEXX社)

- 先端パッケージング分野における製品ラインアップ強化

◆ FSI International (現 TEL FSI社)

- 高温SPMによる先端ハイドローストレジスト剥離洗浄技術
- 微細パターンにおけるエアロゾル方式物理洗浄技術

◆ Magnetic Solutions (現 TEL Magnetic Solutions社)

- 次世代メモリSTT-MRAMの中核となる強磁場中熱処理技術

◆ Oerlikon Solar (現 TEL Solar社)

- 中長期的な成長を見据えた新規分野への挑戦

SPM: Sulfuric Acid & Hydrogen Peroxide Mixture (硫酸過水混合液)

STT-MRAM: Spin Transfer Torque-Magneto-resistive Random Access Memory

2013年3月期 開発ハイライト

- ▶ **次世代メモリ、STT-MRAM分野において開発をリード**
東北大学およびimecとの共同開発プログラムを実施
- ▶ **先端パターンニング技術、DSAの開発を加速**
Litho-Cell分野の強みを活かした独自技術の開発
先端コンソーシアム、imec、letiとの共同開発プログラムを実施
- ▶ **先端3次元実装技術の開発を強化**
製品ラインアップ強化により一貫したモジュール開発を加速
先端顧客との関係強化、共同開発プログラムを実施

DSA: Directed Self-Assembly (誘導自己組織化)

22

市場環境



TOKYO ELECTRON

CORP IR/April 30, 2013



事業環境 2013年4月時点での見方

▶ 半導体設備投資

CY2013の半導体前工程(WFE)の設備投資は、前年比ほぼ同水準を見込む。ロジック向け投資は、ファウンドリによる先端投資は継続されるものの、PCの需要が依然弱く全体としては減少傾向。メモリ向け投資は、旺盛なスマートフォン・タブレット向けの需要に加え、SSD需要の拡大もあり、増加が見込まれる。

▶ FPD設備投資

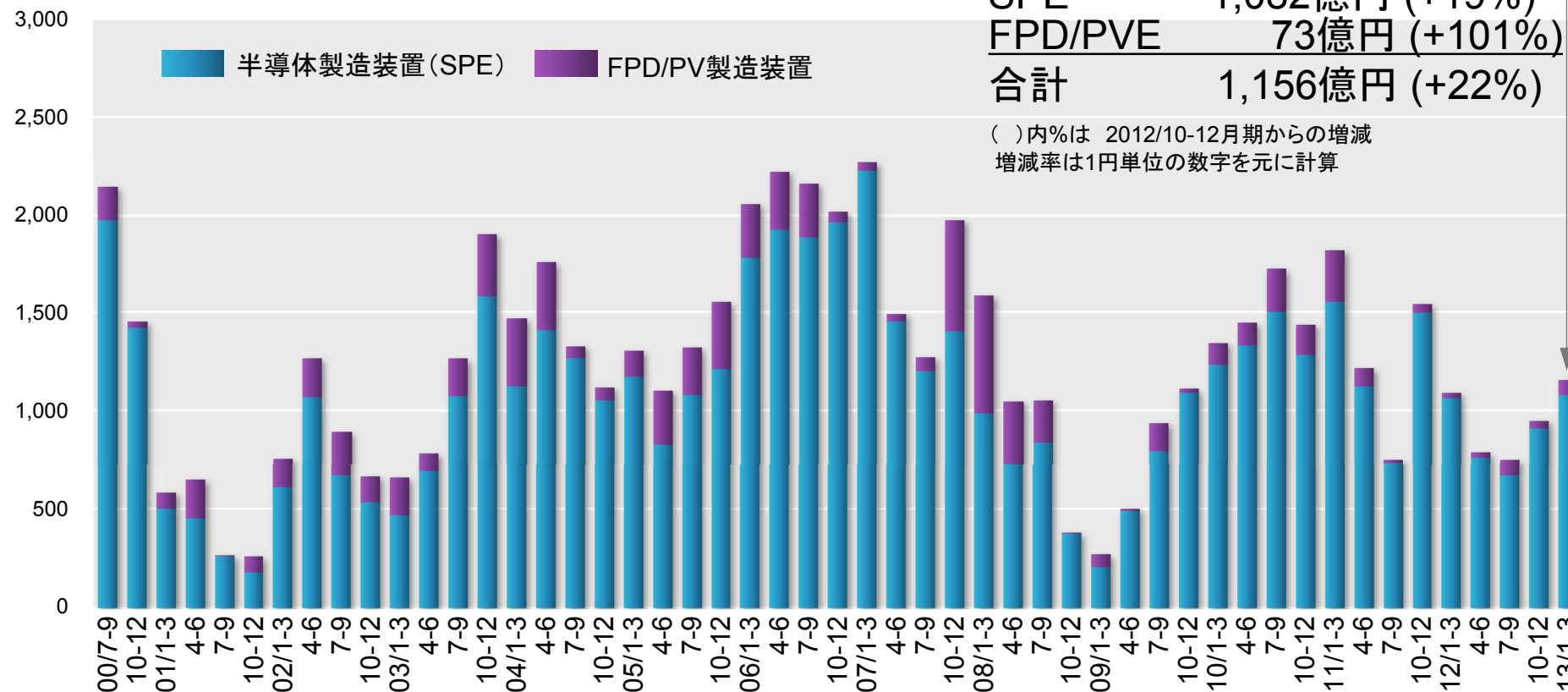
CY2013の液晶パネル用製造装置の需要は、前年比50%前後の増加を見込む。中国における大型パネル向け新規設備投資の再開に加え、中小型パネル向けも引き続き堅調に推移すると見られる。

▶ PV設備投資

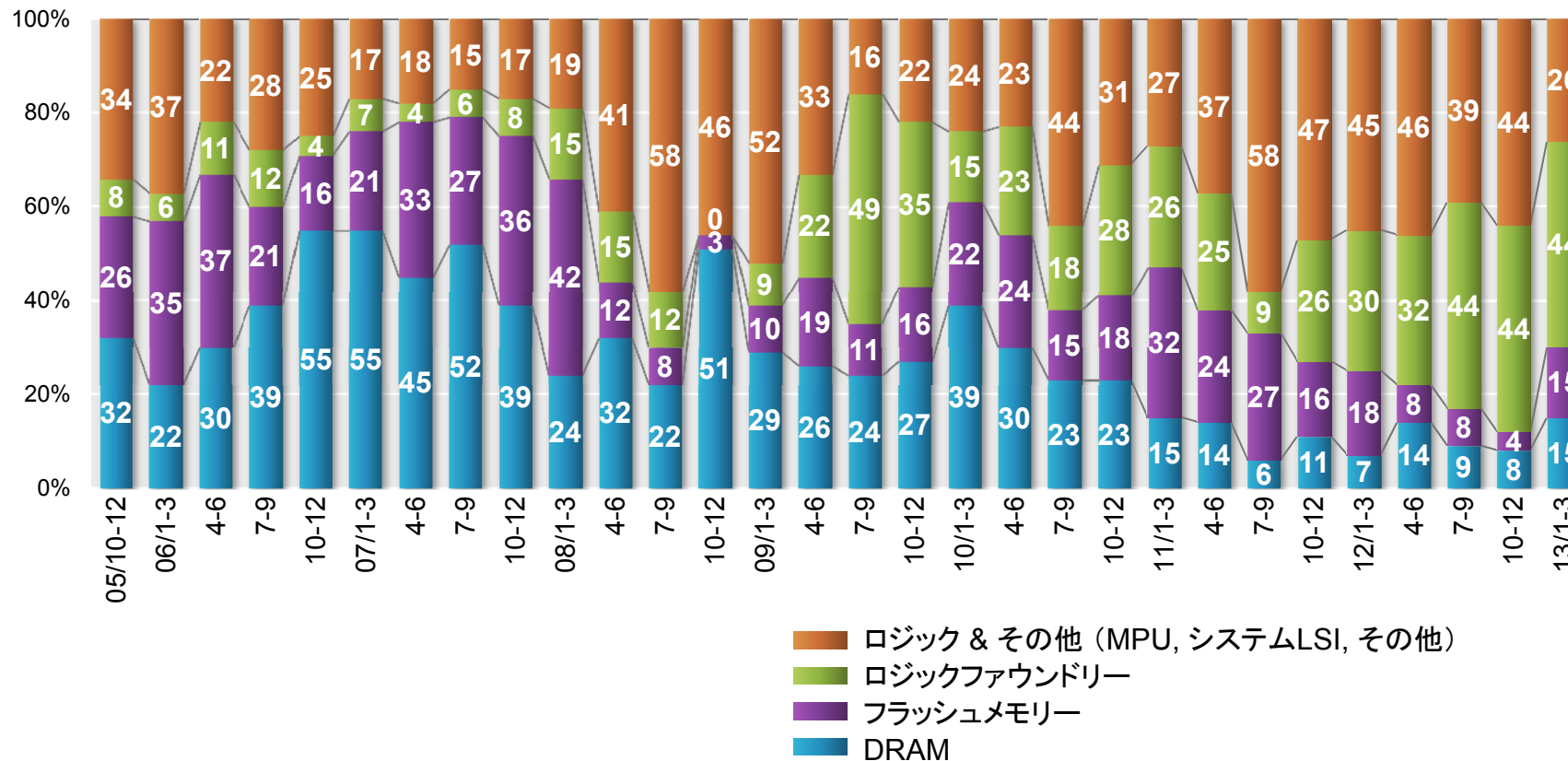
太陽光パネル市場および太陽光発電規模は継続して拡大しており、中長期的な成長が見込まれている。今後、中国ならびにサンベルト地域での発電需要が増大すると予想され、薄膜シリコン・パネル向けの投資増加が期待される。

四半期 受注額

(億円)



四半期 アプリケーション別SPE受注



- ロジック & その他 (MPU, システムLSI, その他)
- ロジックファウンドリー
- フラッシュメモリー
- DRAM

グラフは装置本体受注における構成比を示しています。

2014年3月期業績予想



TOKYO ELECTRON

CORP IR/April 30, 2013



2014年3月期 業績予想

(億円)

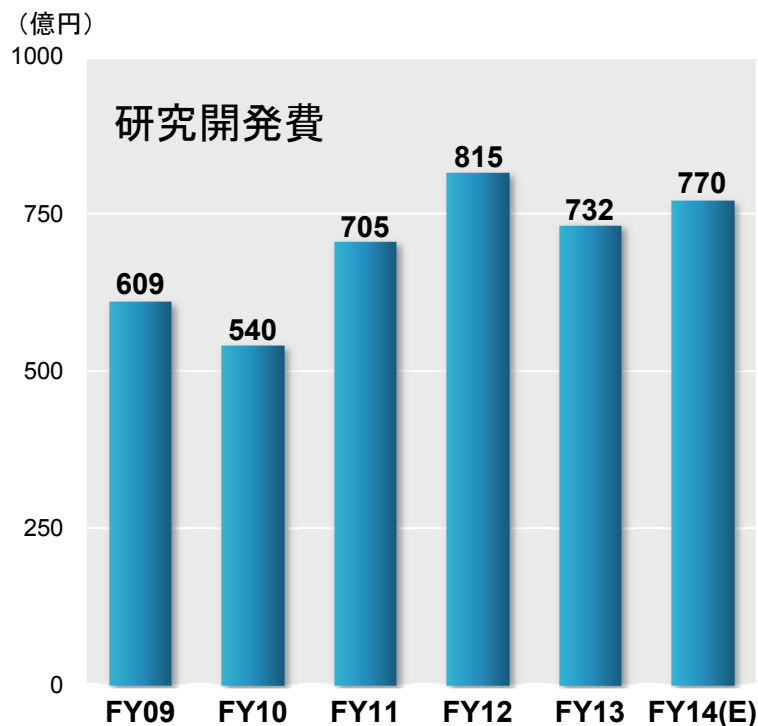
	FY2013	FY2014 (予想)			
		上期	下期	通期	対前年増減
売上高	4,972	2,520	3,180	5,700	+15%
SPE	3,920	1,900	2,400	4,300	+10%
FPD/PVE	201	200	310	510	+153%
EC/CN	846	420	470	890	+5%
その他	4	-	-	-	-
営業利益	125	-80	260	180	+43%
	2.5%	-3.2%	8.2%	3.2%	+0.7pts
税前利益	177	-70	270	200	+13%
当期純利益	60	-30	160	130	+114%
1株当たり当期純利益 (円)	33.91	-16.74	89.29	72.55	+38.64

SPE: 半導体製造装置 FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル製造装置 EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク

先端微細化投資や能力増強投資により
年央からの回復を見込む

28

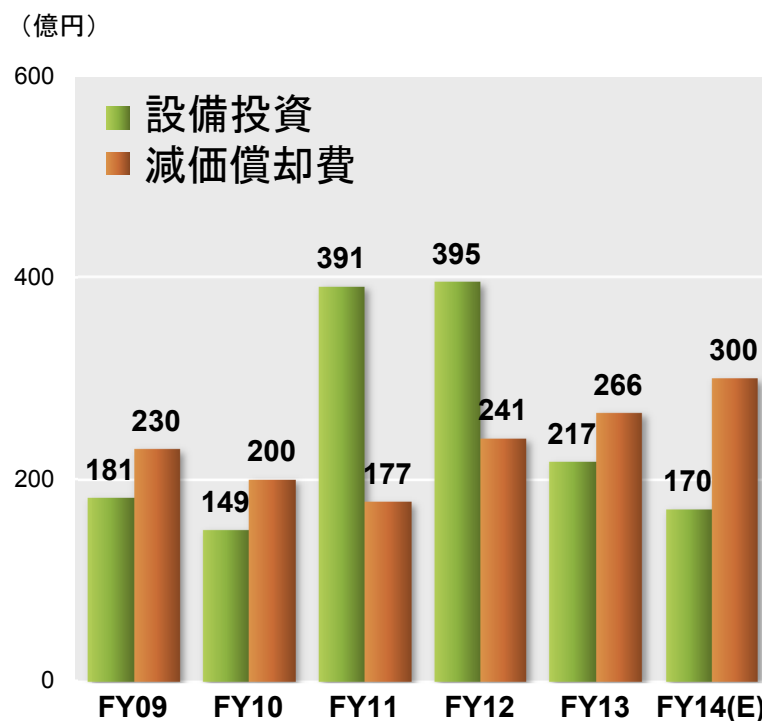
研究開発費・設備投資計画



FY14(E)の研究開発費

- 既存分野 約60%
- 新規分野 約40%

(次世代メモリ、先端パッケージング、有機EL、太陽光パネル等)

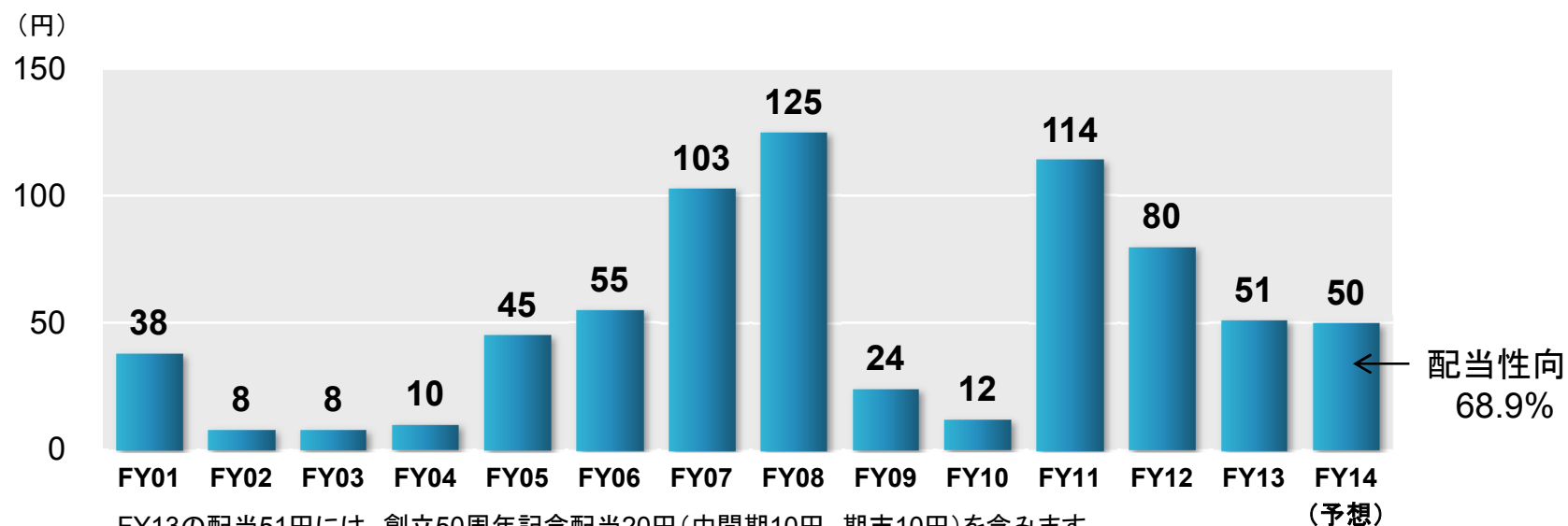


FY13およびFY14(E)の減価償却費には、新規連結子会社4社にかかる減価償却費が、それぞれ13億円、40億円含まれています。

成長分野への開発投資を継続、設備投資は抑制

配当予想

1株当たり配当金 (予想)		
中間配当	期末配当	合計
25円	25円	50円



FY13の配当51円には、創立50周年記念配当20円(中間期10円、期末10円)を含みます。
 FY11の期末配当より、業績連動配当性向を従来の20%目途から35%目途に引き上げています。

業績連動の株主還元方針に変更はないが、
 当社の財務状況と世界経済動向等に鑑みた配当を予定

経営方針

経営方針

- ▶ 技術革新が市場と利益を創造する経営を貫く
- ▶ 顧客第一主義のもと、グローバルレベルで技術サポート力を強化
- ▶ 現場からトップまで、創造性、挑戦意欲、情熱、責任感に満ちた活力のある会社づくり
- ▶ ワールドクラスの高収益体質と更なる成長を実現

▶ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

▶ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

▶ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV:フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル